宇宙用太陽電池の二次アークに対する 安全作動条件取得試験(WG1) 〇 北村 倫基、野村 正行、増井博一、豊田 和弘、趙 孟佑 (九州工業大学)

Measurement of sustained arc threshold for satellite solar arrays (WG1) Tomoki Kitamura Masayuki Nomura, Hirokazu Masui, Kazuhiro Toyoda, and Mengu Cho (Kyushu Institute of Technology)

Key Words: Solar Array, Secondary Arc, Plasma

Abstract

In this paper, we report about the test result for Working Group 1(WG1), which was established to make a Japanese guideline for spacecraft charging design. We investigated threshold conditions of sustained arc inception. The TJ GaAs solar cells were tested. Laboratory tests were carried out with an external circuit simulating a spacecraft power system. Solar array coupon panels simulating the hot and return ends of a string circuit were tested under various combinations of string voltage and string current. We revealed that the threshold conditions of sustained arc formation were different in string voltage even if the string current are same.

1. 目的および背景

近年、太陽電池アレイ上で発生する放電現象が問題となっている¹⁾。宇宙機の電位は周囲のプラズマ環境、日照条件、表面物性などにより決定され、通常の低地球軌道では宇宙機機体電位は発電電圧程度負に沈んでいる。しかし、静止軌道ではサブストーム発生時に機体電位が大きく負になる。この時、二次電子放出係数の違いにより、カバーガラス等の絶縁体と宇宙機構体との導体との間に電位差が生じる。図1に示した太陽電池の構造図において、絶縁体であるカバーガラスの表面電位が機体電位に対し負になる場合を順電位勾配と呼び、正になる場合を逆電位勾配と呼んでいる。



図1 太陽電池の断面

太陽電池アレイ上には図1に示すように局所的に 電界が集中するトリプルジャンクション(導体・絶縁 体・空間)が存在し、周囲の環境との相互作用により 放電が発生することがある。この単発の放電は一次 アーク(Primary Arc、以下 PA)と呼ばれ、太陽電池セ ルの劣化や電磁波による搭載機器の誤動作を引き起 こす。しかし、それ以上に懸念されるのが、PA 直後 の放電プラズマが絶縁体に蓄えられていた電荷を吸 収して成長し、高い電位差を有する太陽電池アレイ の隣り合うセル間を短絡させてしまうことである。 この現象は二次アーク(Secondary arc)と呼ばれ、短 絡電流は発電中の太陽電池アレイ自身により供給さ れるため、その間その回路の出力が失われる。最悪 の場合太陽電池回路の破壊をも引き起こす可能性が ある。二次アークにより太陽電池回路が故障し衛星 の不具合に至った例も報告されている^{1.2}。

二次アークは、短絡現象が自発的に終わる (Temporary Sustained Arc、以下TSA)か、あるいは恒 久的に続く(Permanent Sustained Arc、以下PSA)かに よって数段階にわけられる。図2に各放電の定義を 示す。二次アークの定義について述べる。PA電流波 形のたち下がり部分において、ピーク値 I_{peak}の10% を初めて下回った時間をT_{end}とする。T_{end}以降の時間 において、アーク電流が設定電流値の90%以上流れ ている時間をアークの持続時間(Duration)と定義し、 九州工大では持続時間が2µsec 未満の放電を NSA(Non Sustained Arc)、2µsec 以上をTSA、そして 恒久的に続く放電をPSAと定義している。

二次アークの発生条件は、太陽電池アレイの隣接セ ル間の電圧(以下、V_{ST})、発電電流(以下、列電流 I_{ST})、 隣接セル間のギャップ長、一次アークの規模などと の関係が示唆されているが、未だに不明瞭である。 また、衛星の太陽電池アレイ回路耐性を評価するた めに、打ち上げ前に地上試験が行なわれている。し かし、現在のところ試験条件の国内基準が存在しな い。このことは多メーカ間で製造され、運用されて いる衛星が不具合を起こした際の責任の所在に混乱 を引き起こす恐れがある。そのため、地上試験を行 なう際の試験条件の国内基準というものが必要とさ れている。



本論文では、同一の太陽電池クーポンを用い、列 間電圧、列電流の違いによるTSA、そしてPSAの発 生閾値検証結果について述べる。なお、この実験は 宇宙航空研究開発機構(JAXA)主導による「帯電放電 に関する衛星設計の国内標準」の一環として行われ たものである。

2. 実験

2-1. 太陽電池アレイクーポン

試験で用いたクーポンの写真を図3に示す。クー ポンにはインタコネクタにより直列に接続された 2 枚の三重接合 GaAs 太陽電池セルが 12 組貼付けられ ている。1 枚当たりの大きさは 76mm×37mm であり、 R、B、Gと名付けられた3列で構成されている。各 組の太陽電池セルの P バスバーと N バスバーにはケ ーブルが取り付けられており、このうちギャップを 隔てて、隣接する2組の太陽電池セルから出る4本 のケーブルを外部回路に接続し実験を行っている。 このため、本クーポンでは最大9箇所のギャップを 使用できる。このクーポンの平均ギャップ長は1mm である。なおバスバーは全て RTV (Room Temperature Vulcanization)ゴムで覆われている。クーポンの基板 は、アルミハニカム/CFRP パネルにカプトンフェー スシートを貼ったものであり、裏面はむき出しの CFRP をフィルムで覆っている。PA はクーポン上の 全てのトリプルジャンクションで発生する可能性が あるため、ギャップ以外の金属部分はポリイミドテ ープで覆うことにより放電を抑制させている。

クーポンは大気中から真空チャンバー内に設置し、

真空排気後に必ず 70℃±1℃で 2 時間ベーキングを 行っている。



図3 クーポン概観

2-2. 測定系

図 4 に測定系の模式図を示す。太陽電池アレイは 直径 0.6m、長さ 0.9m の真空チャンバー内に、セル面 を上にしてアクリル板の上に配置されている。クー ポンは真空チャンバーとは電気的に絶縁されている。 試験中、真空チャンバーは 1×10⁻³ 程度まで排気され る。クーポンの真上には電子ビーム銃(ULVAC RHEED)が取り付けられており、試験中は電子ビーム の中心が試験ギャップに照射されるようにクーポン を 設 置 している。クーポンは定電圧電源 Vbias(GlassmanEW60kV)を用いて負にバイアスす る。試験中の発光画像はカメラで撮影され、デジタ ル動画ファイルとして PC に記録される。



図 5 に持続放電試験用の回路を示す。図中の直流 電流源 V₁は、太陽電池の発電中を模擬する電源であ り、PA のような数µsec から数 10µsec の現象に追従 できることが要求される³⁾。そのため、今回の実験で は電流制御ダイオードを超並列にした直流電源を用 いている。この電源は 5nF 以下の低出力キャパシタ ンスと 0.5μ sec 程度の回復時間を達成している。 V_1 の出力電流値が列電流 I_{ST} である。 R_L は擬似負荷抵抗であり、 $C_1 \sim C_3$ は GaAs 太陽電池アレイの 1 直列回路のセル 50 個 1 並列分の容量である。 C_{ext} 、は衛星の全静電容量、 V_{bias} は周囲のプラズマ環境において放電が発生する衛星の電位を表し、PA に放電エネルギーを与える。

PAではCextに蓄えられていた電子が、太陽電池セルからプラズマを介し接地されたチャンバーの壁への経路で流れる。このときに流れる電流をブローオフ電流と呼び、電流プローブ CP₃(HIOKI3274)で測定している。ここで、クーポンについて Vbiasに対しRLの電圧降下分だけ電位が高い方の太陽電池セルの列をHOT、他方をRTN と呼ぶことにする。

図5において定常時の電流は、V1~HOT~RL~RTN ~V1の経路で流れる。これは負荷に電力を供給してい る状態を表している。定電圧源 V2 は RLの電圧降下 よりも僅かに低い電圧値に設定されているため、通 常電流を出力しない。それに対して PA 後の放電プ ラズマが HOT と RTN のセル間(あるいはセル・基板 間)を短絡させると、V2が RLに電流を流すとともに D2が遮断され、V1により RLを流れていた全電流が セル間を流れ、ループを形成する。これが二次アー クの電流経路である。二次アークの判別は、クラン プオン式の直流電流プローブ CP₁(HIOKI 3273)と CP₂(HIOKI 3273)を用いて行う。二次アーク中は CP₁ に V₁ で設定した電流値の電流が検出され、CP₂ には電流が流れない。CP1から CP2の電流値を引い たものが、実際にセル間を流れる放電電流でありア ーク電流(Arc current)と称する。また、電圧値 Vst は、持続放電中数十ボルト程度まで低下する。低下 前の Vsr を列間電圧 (Inter-string voltage or string-substrate voltage)とする。これらの電流プ ローブと高電圧プローブは高速 AD 変換ボード (National Instruments NI5102)に接続されている。 波形データは、高電圧プローブによって測定される アレイ電位の放電による上昇をトリガとして放電波 形が測定され、順次 PC に取り込まれる。



図5 実験回路

2-3. 二次アーク閾値決定方法

各列間電圧につきギャップを 2 つ使用した。こ こでそれらをギャップ A、B と呼称し、区別した。 ギャップ A,B の選定は試験の便宜上、任意に選んで いる。実験では、表 1 の列間電圧と列電流値の条件 で行った。

表1:実験で用いる電圧および電流値

	String Voltage [V]									
	30V		50V		70V		90V		110V	
	5nF	33nF	5nF	33nF	5nF	33nF	5nF	33nF	5nF	33nF
	0.5	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
String	1	2.8	1	1	1.0	1	0.9		1	1
Current	1.5	3.7	1.5	1.5	1.5		1.3		1.2	
[A]	2		2	2			2		1.4	
	2.7								1.5	
	3.3								1.6	
	4								1.8	
									2	

Case1: TSA 閾値検証試験

ギャップ A を使用した。外部容量には 5nF を用い た。試験ギャップにおいて PA を 30 回程度放電させ た。その間に TSA が発生しなければ列電流値を上げ る。これを TSA が発生するまで繰り返す。TSA が発 生した場合はその時点で試験を終了し、その条件値 を TSA 閾値とした。

<u>Case2:PSA 閾値検証試験</u>

ギャップAでTSAが発生した列電流値から試験を 初める。外部容量には5nFを用いる。ギャップでTSA を10回程度発生させ、その間にPSAが発生しなかっ た場合は電流値を上げる。これをPSAが発生するま で繰り返す。PSAが発生した場合はその時点で試験 を終了し、その条件値をPSA 閾値とした。

Case3:外部容量の違いによる TSA 閾値検証試験

基本的にギャップAを用いた(但し、試験の便宜上 90Vと110Vの試験では、全く新しいギャップを用い た)。外部容量には33nFを使用した。実験はCasel で測定されたTSA 閾値電流より一段階小さい電流値 から始めた。その間にTSAが発生しなければPAを 計30回程度放電させ、列電流値を上げる。これを TSAが発生するまで繰り返す。TSAが発生した場合 はその時点で試験を終了し、その条件値をTSA 閾値 とした。このケースの目的は、放電時の静電エネル ギーの大きさが、TSAの発生に影響を与えるかどう かを確認することである。図6に外部容量が5nFと 33nFの場合のブローオフ電流波形を示す。Case3 で はアークへ供給される静電エネルギーの.04Jとな る。これはCase1 での静電エネルギー0.06Jと比べて 約6倍大きい。

カバーガラス1枚あたり、比誘電率 ε r=3.2、面積 S=76mm×37mm、厚さ d=100μm とすると、単位 面積あたりの容量は、およそ $C_{cg}=284nF/m^2$ となる。 太陽電池アレイにおいて、乖離電圧の閾値が V_{diff} の 場合、 Am^2 のカバーガラスに蓄えられている電荷の 静電エネルギーEは、

$$E = \frac{1}{2}C_{cg}AV_{diff}^2$$

で与えられる。ここで、V_{diff}=800V⁴⁾とすると、E=0.4J のエネルギーに供給される太陽電池の面積 A は、

$$A = \frac{\frac{1}{2} (33 \times 10^{-9}) (5 \times 10^{3})^{2}}{\frac{1}{2} (284 \times 10^{-9}) (8 \times 10^{2})^{2}} \approx 4.5m^{2}$$

となる。よって、外部容量 33nF の条件は、太陽電 池パネル 4.5m²に相当する。



試験条件を表2に示す。図5の試験回路において V_{bias} =-5kVである。表2の条件でビームを照射し、逆 電位勾配を形成させ、放電試験を行った。



3. 実験結果および考察

3-1. 二次アーク発生の閾値

二次アーク発生の有無に対して、列間電圧と列電 流との関係を図7に示す。



<u>列間電圧 30V:</u>

外部容量が 5nFの場合では、4A まで電流値を上げ 試験を行った。しかし TSA は発生せず、PA の発生 のみ確認された。33nFに容量を増加させた場合にお いても結果は同じであった。ただし 33nFの条件下で は V_1 電源の不具合により十分なデータが取得できて いない。

<u>列間電圧 50V:</u>

外部容量が 5nF の場合では、1.5A で TSA が確認さ れた。PSA は 2A で発生した。外部容量 33nF の場合 では、TSA が 1A でも発生し、外部容量の増加によ る TSA 閾値の低下が確認された。

<u>列間電圧 70V:</u>

外部容量が 5nF の場合では、1.0A で TSA が確認さ れた。PSA は 1.5A で発生した。外部容量を 33nF に すると TSA が 0.5A でも発生し、外部容量の増加に よる TSA 閾値の低下が見られた。

<u>列間電圧 90V:</u>

外部容量 5nF の場合では、0.4A で TSA が確認された。PSA は 2A で発生した。外部容量 33nF では TSA が 0.5A で発生することを確認した。しかし 70V の結果から推測すると、33nF の場合における TSA 閾値は 0.5A 以下である可能性が高く、外部容量による閾値の変化がないとは言い切れない。

<u>列間電圧 110V:</u>

外部容量が 5nF の場合では、0.5A で TSA が確認され、2A で PSA が発生した。外部容量 33nF の場合でも TSA が 0.5A で発生した。しかし 70V の結果から 推測すると 33nF の場合の TSA 閾値は 0.5A 以下であ る可能性が高く、外部容量による閾値の変化がない とは言い切れない。また 70V では 1.5A で PSA が発 生したにも関わらず、110V では 2A まで PSA が発生 しなかった。これは使用したギャップの個体差が影 響している可能性があるが、明確な原因の特定はで きていない。

図 10 に各列間電圧に対する TSA の持続時間の平 均値を示す。なお、110V 1.4A 以上の条件時では、持 続時間がデータ取得範囲を超える放電が多々発生し た。そのため、その都度データ取得範囲を広くして いったが、持続時間データの取りこぼしが幾らかあ る。図 10 より外部容量の増加により、TSA 閾値が下 がった条件において、継続時間が極端に長くなるこ とはないことが分かった。さらに、TSA の継続時間 は、列電流に依存しており、列間電圧や外部容量に 依存しないことが確認された。この結果は、PSA が 50V から 110V まで、同じ程度の列電流値で発生して いる結果と相関がある。



持続時間の変化(列間電圧 110V)

4. まとめ

電子ビーム環境逆電位勾配環境における二次アー ク発生閾値の検証試験を行った。試験にはギャップ 長 1mmのクーポンを用いた。その結果、5つの列間 電圧値に対する二次アークの閾値を取得することが できた。ただし 30V の場合は試験の上限値であった 4A においても二次アークが発生せず、二次アークの 発生を確認できなかった。二次アークの発生閾値電 流は列間電圧の上昇に伴い、低くなっていく傾向が 見られた。また、外部容量が増えることによる二次 アーク発生閾値の低下が確認された。このことは、 静電容量の増加により PA 発生時のプラズマ密度が 増加し、アークが切れにくくなった可能性が理由と して挙げられる。ただし、閾値低下が確認された条 件(列間電圧 50V、70V)における持続時間は、 10~20μsec 程度の比較的小さな TSA しか発生してい ない。以上の結果から、三重接合 GaAs 太陽電池(ギ ャップ長 1mm)の二次アーク閾値を決定した。結果を 以下に示す。

・TSA 閾値:

列間電圧 50V、列電流値 0.5A より大きく 1.0A 以 下

・PSA 閾値:

列間電圧 50V、列電流値 1.5A より大きく 2.0A 以下

5. 今後の課題

今回の実験により、二次アーク閾値が、外部 コンデンサの値によって低下することが確認さ れた。そのため、今後の WG1 試験では、軌道 上における衛星の太陽電池パドル上で発生しう る、一次アークの最悪条件を模擬した試験ケー スを新たに加える。

一次アークの電流波形は、放電点から広がっ た放電プラズマが、太陽電池パドル上のカバー ガラスに蓄えられた電荷を中和しながら周りに 広がっていく際の進展速度と、カバーガラスに 蓄えられていた電荷量で決まる。パドルの大き さを 2.4m×8m、中和進展速度を 10km/s、放電 時の電位差を 800V、カバーガラスの静電容量 (接着剤層を含む)を 286nF/m²、放電点をパ ドル中心と考え、回路シミュレータを用いて、 Rext,Lext,Cext の値を算出した。そして、回路シ ミュレータから算出した電流波形に近い電流波 形を試験で模擬するために、LCR 回路を試験回 路に接続して試験を行うことにした。その試験 回路を図 11 に示す。



実際に図 11 の回路で得られた一次アーク波 形を、回路シミュレータから得られた波形とと もに図 12 に示す。





現時点では、計算結果から得た波形と全く同 じ波形を作り出すことができないため、電流ピ ーク値とパルス幅、電荷量のみを合わせている。 2.4m×8m のパドルで流れる一次アークの電流 波形を用いて試験することで、この大きさのパ ドル以下のものについては、これから測定して く二次アーク閾値が適用できる。ただし、持続 放電は外部コンデンサの影響を受けないため、 試験で得られた持続放電閾値については 2.4m ×8m 以上のものについても適用できる。次に 図 11 の回路図で新たに追加されたキャパシタ ンス CBP について説明する。このキャパ新タン スを取り付けることにしたのは、HOT 列で一次 アークが発生した際、 V_1 電源が、列間に二次ア ークの電流を供給することができなくなってい る現象を阻止するためである。これは、放電電 流が、回路内の可変抵抗に流れることによって 電位差が上昇していることが原因であると考え られる。そのため、列間電圧が上昇している間 は二次アークに移行することがない。そこで、 実際の人工衛星の電源部にも接続されているバ スキャパシタンスを模擬したコンデンサを列間 に接続することで、列間電圧の上昇を軽減させ ることにした。結果、V1電流の減少も軽微なも のとなった。これにより、二次アークの発生確 率が上昇し、試験時間の短縮化につながると考 える。

参考文献

- [1] Katz,I.,Davis, V.A. and Snyder,D.B,: "Mechanism for Spacecraft Charging Initiated Destruction of Solar Arrays in GEO", AIAA paper 98-1002, 36th Aerospace Science Meeting, Reno, (Jnuary1998)
- [2] 趙孟佑,藤井治久;宇宙環境での帯電・放電現象 についての研究動向と将来課題:高電圧太陽電池

アレイの放電現象と将来課題、日本航空宇宙学会 誌,51(2003),pp.139-145

- [3] D.Payan, "Risks of low voltage arcs sustained by the photovoltaic power of a satellite solar array during an electrostatic discharge. Solar Arrays Dynamic Simulator", (2001)
- [4] 豊田和弘,松本利明、志方吉夫、趙孟佑、佐藤哲 夫、野崎幸重;超高速インターネット衛星搭載用 太陽電池アレイの地上試験、日本航空宇宙学会論 文集、52(2004)、pp.328.-336
- [5] 麻生誠司,趙孟佑;低地球軌道プラズマ環境下での二次アーク発生条件、日本航空宇宙学会 誌,53(2005),pp.516-523
- [6] 北村倫基,趙孟佑;太陽電池アレイにおける持続 放電現象の閾値取得方法、第2回宇宙環境シンポ ジウム, pp.138-144